








	<h2>SIR172DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR172DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 20A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIR172DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 150558 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIR172DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 20A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	150558 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 20A (Tc) 29.8W (Tc) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	29.8W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.9 mOhm @ 16.1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	997pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIR172DP-T1-GE3CT

SIR172DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIR172DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIR172DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIR172DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIR172DP-T1-E3 VISHAY SIR172DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIR186DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SIR172ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 24A 8-SO</p>	 <p>SIR184DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 60V POWERPAK SO-8</p>
 <p>SIR180DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 60V POWERPAK SO-8</p>	 <p>SIR172DP SI SIR172DP SI</p>	 <p>SIR172ADP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 24A 8-SO</p>	 <p>SIR186DP-T1-GE3 Vishay Precision Group SIR186DP-T1-GE3 Vishay</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SIR-56SB3F	↔ SIR-56ST3F	⇒ SIR-59SSTA47	D SIR11-21C/TR8	⇒ SIR15-21C/TR8
⊣ SIR158DP	⊛ SIR158DP-T1-E3	D SIR158DP-T1-GE3	⇒ SIR158DP-T1-GE3	⇒ SIR164ADP-T1-GE3
⊛ SIR164DP	⊣ SIR164DP-T1-E3	⊛ SIR164DP-T1-GE3	↔ SIR164DP-T1-GE3	⇒ SIR166DP
D SIR166DP-T1-E3	⊛ SIR166DP-T1-GE3	⊣ SIR166DP-T1-GE3	⊛ SIR168DP	⇒ SIR168DP-T1-GE3
⇒ SIR168DP-T1-GE3	↔ SIR172ADP-T1-GE3	⊛ SIR172ADP-T1-GE3	⊣ SIR172DP	⇒ SIR172DP-T1-E3
↔ SIR172DP-T1-GE3	⇒ SIR330DP-T1-GE3	D SIR330DP-T1-GE3	⊛ SIR402DP-T1-GE3	⊣ SIR402DP-T1-GE3
⊛ SIR403EDP-T1-GE3	D SIR403EDP-T1-GE3	⇒ SIR404DP	↔ SIR404DP-T1-E3	⇒ SIR404DP-T1-GE3
⊣ SIR404DP-T1-GE3	⊛ SIR406DP	↔ SIR406DP-T1-E3	⇒ SIR406DP-T1-GE3	⇒ SIR406DP-T1-GE3
⊛ SIR406DP-T1-GE3-S	⊣ SIR408DP-T1-GE3	⊛ SIR408DP-T1-GE3	D SIR410DP-T1-E3	⇒ SIR410DP-T1-GE3
↔ SIR410DP-T1-GE3	⊛ SIR412DP	⊣ SIR412DP-T1-E3	⊛ SIR412DP-T1-GE3	⇒ SIR412DP-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited